

ニュースリリース

2026年10月14日

米国アリゾナ拠点に約30億円を投資し、先端半導体の需要増に対応

先端半導体材料CMPスラリーの新規生産設備を導入

先端パッケージング用途などの多様化する半導体製造プロセス向け新製品の安定供給体制を強化

富士フイルム株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長・CEO:後藤 禎一)は、半導体材料事業をさらに拡大するため、米国のアリゾナ州メサ市にある生産・開発拠点(以下、アリゾナ拠点)において、銅配線用CMPスラリー^{*1}の生産設備を増強します。また、先端パッケージング用途などの多様化する半導体製造プロセス向けCMPスラリーの多品種生産に対応した生産設備を新設します。なお、設備投資の総額は、約1,800万米ドル(約30億円)です。

近年、AI関連需要の急拡大を背景として、先端半導体市場は大きな成長局面のさなかにあります。世界の半導体需要は急速に拡大しており、先端半導体製造に不可欠なCMPスラリーの需要も増加しています。特に当社が世界トップシェアを有する銅配線用CMPスラリーについては、先端ロジックおよび先端メモリー分野を中心に需要が拡大しています。また米国では、大手半導体メーカーによる設備投資や、アジアを本拠地とする大手半導体メーカーによる新工場建設が継続しており、今後もCMPスラリー需要の大幅な伸長が見込まれています。

当社は、こうした市場環境を踏まえ、CMPスラリーの生産・開発の中核拠点であるアリゾナ拠点において、銅配線用CMPスラリーの生産能力を増強します。

さらに、当社は、BEOL^{*2}で使われる銅配線用CMPスラリーだけでなく、FEOL^{*3}、MOL^{*4}といったBEOL以外の前工程用CMPスラリーや、ハイブリッドボンディングをはじめとした先端パッケージング用途を含む、前工程・後工程向けの多品種生産に対応したCMPスラリーの生産設備も新設します。新設する生産設備は、CMPスラリーのグローバル開発を担うアリゾナ拠点の研究開発センターの開発成果を迅速に量産へとつなぐ役割を担います。これにより、製品開発から量産までを迅速かつ柔軟に推進できる体制を整え、新たな事業分野への展開を加速します。

新設備の稼働開始は、2027年を予定しています。本投資により、アリゾナ拠点におけるCMPスラリーの生産能力を増強し、中長期的な需要増に対応できる供給体制を整備します。

当社は、フォトレジスト^{*5}やフォトリソグラフィ周辺材料^{*6}、CMPスラリー、ポストCMPクリーナー^{*7}、薄膜形成材^{*8}、ポリイミド^{*9}をはじめとした感光性絶縁膜材料「ZEMATES(ゼマテス)^{™*10}」、高純度プロセスケミカル^{*11}など半導体製造の前工程から後工程までのプロセス材料や、イメージセンサー用カラーフィルター材料をはじめとした「Wave Control Mosaic(ウェイブ コントロール モザイク)^{™*12}」などをグローバルに展開しています。

当社は今後も、最先端からレガシーノードまで半導体製造プロセスのほぼ全域に豊富なラインアップの製品を提供し、日米欧アジアに製造拠点を有するグローバルな安定供給体制を高い研究開発力と技術力により構築し、半導体材料事業のさらなる発展に貢献していきます。

Cookieの利用について

このウェブサイトはクッキーを使用しています。このサイトを使用することにより、プライバシーポリシー に同意したことになります。

- 2026/10/14 9:40
- 先端半導体材料CMPスラリーの新規生産設備を導入 | 富士フイルム [日本]
- *1 硬さの異なる配線や絶縁膜が混在する半導体表面を均一に平坦化する研磨剤。CMPは、Chemical Mechanical Polishing(化学的機械研磨)の略。

*2 BEOL(Back End of Line／バックエンドオブライン・配線層):ウエハー上に作製したトランジスタなどの素子同士を金属配線で接続し、電気信号のやり取りができるようにする配線工程。

*3 FEOL(Front End of Line／フロントエンドオブライン・素子形成層):ウエハーの表面に、トランジスタやキャパシタ、抵抗などの素子を形成する工程。

*4 MOL(Middle of Line／ミドルオブライン・中間接続層):FEOLで形成したトランジスタの各端子と配線層の最下層とを接続するための中間的な接続工程。

*5 半導体製造の工程で、光による化学反応を利用して回路パターンの描画を行う際にウエハー上に塗布する感光性材料。

*6 半導体製造のフォトリソグラフィー工程で使用する現像液やクリーナーなど。

*7 CMPスラリーによる研磨後に、金属表面を保護しながら、粒子、微量金属および有機残留物を洗浄するクリーナー。

*8 低誘電率の絶縁膜を形成するための材料。

*9 高い耐熱性や絶縁性を持つ材料。半導体の保護膜や再配線層の形成に使用される。

*10 ZEMATESは、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。

*11 洗浄・乾燥工程に使われる高純度薬品。半導体製造の洗浄・乾燥工程で異物を除去したり、エッチング工程にて金属や油脂などを取り除くために使用する化学薬品。

*12 広範囲な波長の電磁波(光)をコントロールする機能性材料群の総称。デジタルカメラやスマートフォンに用いられるCMOSセンサーなどのイメージセンサーのカラーフィルターを製造するための着色感光材料を含む。Wave Control Mosaicは、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。

設備投資の概要

総投資金額	約1,800万米ドル(約30億円)
投資内容	銅配線用CMPスラリー生産設備 多品種用CMPスラリー生産設備
稼働開始時期	2027年

米国アリゾナ州メサ市にある生産・開発拠点の概要

社名	FUJIFILM Electronic Materials U.S.A., Inc.
所在地	6550 S Mountain Rd, Mesa, AZ 85212
現在の生産品目	フォトリソグラフィー周辺材料、CMPスラリー、薄膜形成材

お問い合わせ	報道関係	その他
	富士フイルムホールディングス株式会社 コーポレートコミュニケーション部 広報グループ TEL 03-6271-2000	富士フイルム株式会社 エレクトロニクスマテリアルズ事業部 E-mail: shm-ff-em_inquiries@fujifilm.com

* 記事の内容は発表時のものです。最新情報と異なる場合(生産・販売の終了、仕様・価格の変更、組織・連絡先変更等)がありますのでご了承ください。

富士フイルム広報 X(旧Twitter)

一覧へ戻る